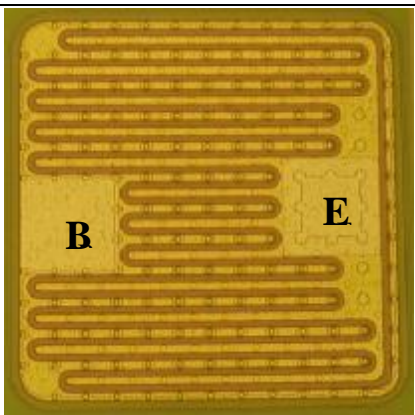


产品资料

几何参数

管芯尺寸 (MASK)		0.89 × 0.89 mm	
管芯厚度		210 ± 20 μm	
压焊区尺寸	基极	200 × 200 μm	
	发射极	200 × 200 μm	
正面金属层		Al	
背面金属层		Au	
圆片尺寸		Φ 125 mm	
每片有效管芯数		13,100	

极限值 (绝对最大额定值) (Ta=25°C) TO-126

参数	符号	规格	单位
集电极-基极电压	V_{CBO}	-20	V
集电极电流	I_C	-4	A
集电极功耗	P_C	10	W
结温	T_j	150	°C

电特性 (Ta=25°C)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	$I_C = -0.05 \text{ mA}$, $I_E = 0$	-20			V
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C = -0.1 \text{ mA}$, $I_B = 0$	-12			V
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	$I_E = -0.05 \text{ mA}$, $I_C = 0$	-6			V
集电极-基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB} = -20 \text{ V}$, $I_E = 0$			-0.1	μA
发射极-基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB} = -6 \text{ V}$, $I_C = 0$			-0.1	μA
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE} = -2 \text{ V}$, $I_C = -0.5 \text{ A}$	140		600	
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -2 \text{ A}$, $I_B = -50 \text{ mA}$			-0.5	V
基极-发射极饱和电压	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -2 \text{ A}$, $I_B = -50 \text{ mA}$			-1.5	V
特征频率	f_T	$V_{CE} = -5 \text{ V}$, $I_C = -0.1 \text{ A}$, $f = 10 \text{ MHz}$	50	80		MHz



扬州晶新微电子有限公司